|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника та членів проектної групи | Найме-нування посади  (для суміс- ників — місце основної роботи, наймену-вання посади) | Найменування закладу, який закінчив викладач  (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) | Науковий ступінь,  шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно | Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи |  |  |
| **Оліх Олег Ярославович** | Завідувач кафедри загальної фізики | Київський університет імені Тараса Шевченка,  1996 р.  Спеціальність: фізика твердого тіла.  Кваліфікація: Фізик. Викладач (диплом з відзнакою ЛТ ВЕ №001760 виданий 28 червня 1996 р) | Доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла (диплом ДД №008094, 18.12.2018)  „Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах”.  Професор за кафедрою загальної фізики (атестат АП №004651, 23.12.2022) | 27 років | Автор більше 100 наукових публікацій, 13 навчальних посібників, участь у близько 40 конференціях, під керівництвом захищено більше 20 кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів.   1. Olikh O., Datsenko O., Kondratenko S. «Influence of Illumination Spectrum on Dissociation Kinetics of Iron–Boron Pairs in Silicon», Physica Status Solidi (a), 2024, Vol.221, is.17, 2400351; https://doi.org/10.1002/pssa.202400351 2. Olikh O. «A test of meta-heuristic algorithms for parameter extraction of next-generation solar cells with S-shaped current–voltage curves», Materials Science and Engineering B, 2024, Vol.307, 117506; https://doi.org/10.1016/j.mseb.2024.117506 3. Olikh O., Lytvyn P. «Defect engineering using microwave processing in SiC and GaAs», Semiconductor Science and Technology, 2022, vol.37, Is.7, 075006; https://doi.org/10.1088/1361-6641/ac6f17 4. Olikh O., Lozitsky O., Zavhorodnii O. «Estimation for iron contamination in Si solar cell by ideality factor: Deep neural network approach», Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2022, vol.30, is.6, p. 648-660; https://doi.org/10.1002/pip.3539 5. Olikh O.Ya., Voytenko K.V. «On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon-based Schottky diodes», [Ultrasonics](http://www.sciencedirect.com/science/journal/0041624X), 2016, vol.66, p. 1-3; https://doi.org/10.1016/j.ultras.2015.12.001 | University of Białystok, Poland, сертифікат №7, 6 кредитів, Іnternational postgraduate practical internship «Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives», 2022 р;  КНУТШ, сертифікат №565-22, 3 кредити, програма «Роль гарантів програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти», 2022 р;  SoftServe Academy, сертифікат EM № 9305/2022, 3,5 кредити, course “TEACHER'S DEVOPS COURSE”, 2022 р.;  SoftServe Academy, сертифікат ZV № 17710/2024, 4 кредити, course “Cloud environment configuration and security”, 2024 р. |